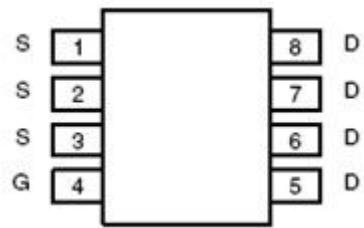


$V_{DS} = -20V$
 $R_{DS(ON)}, V_{GS}@-10V, I_{ds}@-2.7A = 68m\Omega@TYP$
 $R_{DS(ON)}, V_{GS}@-4.5V, I_{ds}@-2.7A = 88m\Omega@TYP$

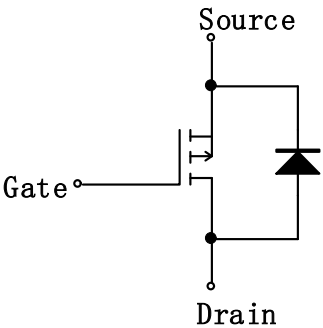
特点

- 高级的加工技术
- 极低的导通电阻高密度的单元设计
- 改良的成型工艺

封装图：SOP-8



内部结构示意图



P-Channel MOSFET

最大额定值和热特性 (TA=25℃，除非另有说明。)

| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
|-------------|----------------|------------|----|
| 漏源电压 | V_{DS} | -20 | V |
| 栅源电压 | V_{GS} | ± 8 | |
| 漏极电流 | I_D | -4 | A |
| 漏极脉冲电流 | I_{DM} | -12 | |
| 工作结温和存储温度范围 | T_J, T_{stg} | -55 to 150 | ℃ |

注：重复性极限值：脉冲宽度由最高结温限制。

9435

20V P 沟道增加型 MOS 场效应管

电特性

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|------------|--------------|------------------------------------|------|-------|-------|----|
| 静电 | | | | | | |
| 漏源击穿电压 | BV_{DSS} | $V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$ | -20 | -- | -- | V |
| 漏源电阻 | $R_{DS(on)}$ | $V_{GS} = -4.5V, I_D = -2.7A$ | -- | 88.0 | 100.0 | mΩ |
| | $R_{DS(on)}$ | $V_{GS} = -10V, I_D = -2.7A$ | -- | 68.0 | 85.0 | |
| 栅极阈值电压 | $V_{GS(th)}$ | $V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu A$ | -0.5 | -0.75 | -1 | V |
| 栅源短路时漏极电流 | I_{DSS} | $V_{DS} = -16V, V_{GS} = 0V$ | -- | -- | -1 | μA |
| 漏极短路时截止栅电流 | I_{GSS} | $V_{GS} = \pm 8V, I_{DS} = 0V$ | -- | -- | ±100 | nA |
| 漏源二极管 | | | | | | |
| 二极管最大正向电流 | I_S | -- | -- | -- | -4.0 | A |
| 二极管正向电压 | V_{SD} | $I_S = -1A, V_{GS} = 0V$ | -- | -- | -1.3 | V |

注：1、脉冲测试：脉冲宽度≤ 300μs，占空比≤ 2%